

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук**  
объявляет конкурс на замещение вакантной должности  
*младшего научного сотрудника*  
в лаборатории фотоэлектрических преобразователей  
**Вакансия VAC\_PTI\_22035**

**Тематика исследований**

«Технология производства фотоэлектрических преобразователей на основе InP»

**Трудовая деятельность**

Участие в научных исследованиях по разработке технологии производства фотоэлектрических преобразователей на основе InP, включая:

- подготовку подложек;
- эпитаксиальное выращивание структур на установке МОСГФЭ Aixtron AIX-200;
- обслуживание установки МОСГФЭ Aixtron AIX-200
- осуществление экспресс-контроля характеристик выращенных структур;
- электрохимическое нанесение покрытий на поверхность полупроводников и структур;
- разработка и монтаж электрических схем;
- разработку технологии получения фотоэлектрических преобразователей
- разработку технологии нанесения электрических и диэлектрических покрытий на InP
- постростовое исследование характеристик диодов;
- подготовку и публикацию статей по материалам исследований, апробацию работ на научных конференциях, участие в грантах.

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя заведующим лабораторией.

**Требования к претенденту:**

- квалификация - магистр по специальности «Приборостроение»;
- опыт работы на оборудовании роста структур методом МОСГФЭ;
- опыт работы с установкой МОСГФЭ Aixtron AIX-200;
- опыт разработки полупроводниковых приборов;
- опыт в проектировании и обслуживании электрических приборов и схем
- опыт подготовки полупроводниковых структур для различных видов исследований;
- опыт проведения электрохимических процессов;
- опыт измерений характеристик полупроводниковых приборов;
- опыт участия в научных проектах Российского научного фонда
- является автором не менее 5 публикаций в рецензируемых научных изданиях, в том числе в журналах участвующих в системах WoS и Scopus
- является автором не менее 1 патента РФ.

**К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы**

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной (научно-организационной) работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя.

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 23 800 руб.

СТАВКА: 1.0

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 18 000 руб.

Срок трудового договора – 5 лет

**К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы:**

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, ученому секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок: (812) 297 22 45.